

NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE
TRANSISTORS NPN SILICIUM, BASE EPITAXIEE

BD 241, BD 241A
BD 241B, BD 241C

Compl. of BD 242, A, B, C

PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

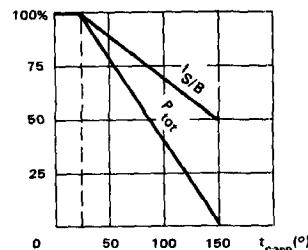
- Complementary symmetry stages amplifiers
Etages amplificateur à symétrie complémentaire
- Switching
Commutation

V_{CEO}	45 V	BD 241
	60 V	BD 241 A
	80 V	BD 241 B
	100 V	BD 242 C
I_C	3 A	
P_{tot}	40 W	

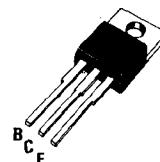
$R_{th(j-c)}$	3,1 °C/W max
t_{on}	0,3 µs typ.
t_{off}	1 µs typ.

Plastic case TO-220 AB — See outline drawing CB-117 on last pages
Boîtier plastique TO-220 AB — Voir dessin coté CB-117 dernières pages

Dissipation and $I_{S/B}$ derating
Variation de dissipation et de $I_{S/B}$



Weight : 2 g.
Masse



Collector is connected to case
Le collecteur est relié au boîtier

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

$t_{case} = 25^\circ\text{C}$

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

		BD 241	BD 241 A	BD 241 B	BD 421 C	
Collector-emitter voltage Tension collecteur-émetteur	V_{CEO}	45	60	80	100	V
Collector-emitter voltage $R_{BE} = 100 \Omega$	V_{CER}	50	70	90	115	V
Emitter-base voltage Tension émetteur-base	V_{EBO}	5	5	5	5	V
Collector current Courant collecteur	I_C	3	3	3	3	A
Base current Courant base	I_B	1	1	1	1	A
Power dissipation Dissipation de puissance	$t_{amb} = 25^\circ\text{C}$	2	2	2	2	W
	$t_{case} = 25^\circ\text{C}$	40	40	40	40	W
Junction temperature Température de jonction	max	t_j	150	150	150	150
	min					°C
Storage temperature Température de stockage	max	t_{stg}	-65 +150	-65 +150	-65 +150	-65 +150
	min					°C

BD 241, BD 241 A, BD 241 B, BD 241 C

**STATIC CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES STATIQUES**

$t_{amb} = 25^\circ C$

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

	Test conditions Conditions de mesure			Min.	Typ.	Max.
Collector-emitter cut-off current <i>Courant résiduel collecteur-émetteur</i>	$V_{CE} = 30 V$ $I_B = 0$	I_{CEO}			0,5	mA
Collector-emitter cut-off current <i>Courant résiduel collecteur-émetteur</i>	$V_{CE} = 45 V$ $V_{BE} = 0$	I_{CES}	BD 241		0,3	mA
	$V_{CE} = 60 V$ $V_{BE} = 0$		BD 241 A		0,3	mA
	$V_{CE} = 80 V$ $V_{BE} = 0$		BD 241 B		0,3	mA
	$V_{CE} = 100 V$ $V_{BE} = 0$		BD 241 C		0,3	mA
Emitter-base cut-off current <i>Courant résiduel émetteur-base</i>	$V_{EB} = 5 V$ $I_C = 0$	I_{EBO}			1	mA
Collector-emitter breakdown voltage <i>Tension de claquage collecteur-émetteur</i>	$I_C = 100 mA$ $I_B = 0$	$V_{CEO(sus)}^*$	BD 241	45		V
			BD 241 A	60		V
			BD 241 B	80		V
			BD 241 C	100		V
Static forward current transfer ratio <i>Valeur statique du rapport de transfert direct du courant</i>	$V_{CE} = 4 V$ $I_C = 1 A$	h_{21E}^*		20		V
	$V_{CE} = 4 V$ $I_C = 3 A$			8		V
Collector-emitter saturation voltage <i>Tension de saturation collecteur-émetteur</i>	$I_C = 3 A$ $I_B = 0,6 A$	V_{CEsat}^*			1,2	V
Base-emitter voltage <i>Tension base-émetteur</i>	$V_{CE} = 4 V$ $I_C = 3 A$	V_{BE}^*			1,8	V

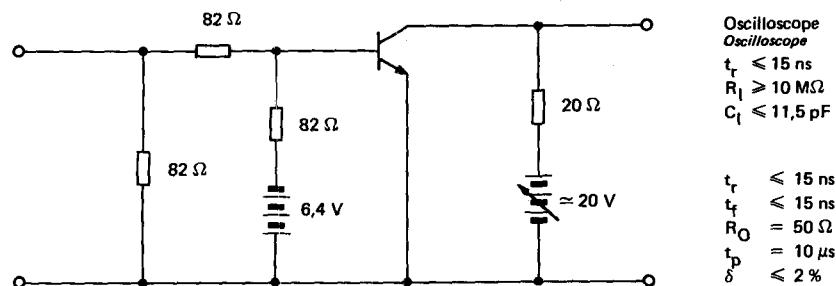
* Pulsed $t_p = 300 \mu s$ $\delta \leq 2\%$
Impulsions

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTÉRISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
 $t_{case} = 25^\circ\text{C}$ (Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

	Test conditions Conditions de mesure			Min.	Typ.	Max.
Forward current transfer ratio <i>Rapport de transfert direct du courant</i>	$V_{CE} = 10 \text{ V}$ $I_C = 0,5 \text{ A}$ $f = 1 \text{ kHz}$	h_{21e}		20		
Transition frequency <i>Fréquence de transition</i>	$V_{CE} = 10 \text{ V}$ $I_C = 0,5 \text{ A}$ $f = 1 \text{ MHz}$	f_T		3		MHz
Turn-on time <i>Temps total d'établissement</i>	$I_C = 1 \text{ A}$ $I_{B1} = 0,1 \text{ A}$	$t_d + t_r$		0,3		μs
Turn-off time <i>Temps total de coupure</i>	$I_C = 1 \text{ A}$ $I_{B1} = 0,1 \text{ A}$ $I_{B2} = -0,1 \text{ A}$	$t_s + t_f$		1		μs

THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES

Junction-case thermal resistance <i>Résistance thermique (jonction-boîtier)</i>		$R_{th(j-c)}$		3,1	$^\circ\text{C/W}$
Junction-ambient thermal resistance <i>Résistance thermique (jonction-ambiente)</i>		$R_{th(j-a)}$		62,5	$^\circ\text{C/W}$

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION
All resistances are non inductive
Toutes les résistances de type non inductif* Pulsed Impulses $t_p = 300 \mu\text{s}$ $\delta \leq 2 \%$

SAFE OPERATING AREA
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE

